

XII ENCONTRO NACIONAL DE FÍSICA DA
MATERIA CONDENSADA, Coxambú,
9-13 maio de 1989

0050502368

SEM13/16:30:58f.	FILMES DE GaAs DOPADOS COM SILÍCIO, CRESCIDOS POR MBE: CARACTERIZAÇÃO E MORFOLOGIA DA SUPERFÍCIE - P. Bazma, M.S. Li, A.M. Ceschin, J. Mjollisto, E. Minami, E. Manzoli e B. Scherapke - Instituto de Física e Química de São Carlos - USP. (* CNRS - França)
322 378 319 223 320 321 Filmes de GaAs dopados com silício foram crescidos por MBE, com espessura de 3 a 4 µm. Os mesmos foram caracterizados por medidas de efeito Hall, fotoluminescência e fotocondutividade à temperatura de 77 K. Mostramos também resultados com relação à morfologia da superfície obtidos por SEM.	

00001037

513 (1)

Campo	Dado
*****	Documento 1 de 1
No. Registro	000786089
Tipo de material	TRABALHO DE EVENTO-RESUMO - NACIONAL
Entrada Principal	Basmaji, Pierre (*)
Título	Filmes de 'GA"AS' dopados com silício , crescidos por mbe : caracterizacao e morfologia da superficie.
Imprensa	São Paulo : Sociedade Brasileira de Fisica, 1989.
Descrição	p.239.
Autor Secundário	Siu Li, Máximo
Autor Secundário	Ceschin, A M (*)
Autor Secundário	Migliato, J (*)
Autor Secundário	Minami, E (*)
Autor Secundário	Manzoli, E (*)
Autor Secundário	Scharappe, B (*)
Autor Secundário	Encontro Nacional de Fisica da Materia Condensada (12. 1989 Caxambu)
Fonte	Programa e Resumos, São Paulo : Sociedade Brasileira de Fisica, 1989
Unidade USP	IFQSC-F -- INST DE FÍSICA DE SÃO CARLOS
Localização	IFSC PROD001037